

(19)日本国特許庁(JP)

## (12)特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第7062216号

(P7062216)

(45)発行日 令和4年5月6日(2022.5.6)

(24)登録日 令和4年4月22日(2022.4.22)

(51)国際特許分類

G 0 1 R 33/02 (2006.01)

F I

G 0 1 R 33/02

B

請求項の数 5 (全10頁)

(21)出願番号	特願2018-84600(P2018-84600)	(73)特許権者	713000630
(22)出願日	平成30年4月25日(2018.4.25)		マグネデザイン株式会社
(65)公開番号	特開2019-191016(P2019-191016 A)		愛知県名古屋市中区福江二丁目9番3 3号
(43)公開日	令和1年10月31日(2019.10.31)	(72)発明者	本蔵 義信
審査請求日	令和3年2月11日(2021.2.11)		愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台3 3番地の10
審判番号	不服2021-14907(P2021-14907/J 1)	(72)発明者	本蔵 晋平
審判請求日	令和3年11月2日(2021.11.2)		愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台3 3番地の10
早期審理対象出願		(72)発明者	工藤 一恵
			愛知県名古屋市中川区三ツ屋町1丁目2 7番地の1
		(72)発明者	田辺 淳一
			愛知県中川区松葉町1丁目20番地の1
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 超薄型高感度磁気センサ

## (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

特定用途向け集積回路（以下、ASICという。）と磁界検出素子とを備えてなり、前記磁界検出素子は、基板皮膜に形成された溝に配置した磁性ワイヤと前記磁性ワイヤを周回する検出コイルと電極とからなり、前記基板皮膜は、前記ASICの絶縁保護被膜の上面に形成された絶縁性レジスト層からなることを特徴とする超薄型高感度磁気センサ。

## 【請求項2】

請求項1に記載されている超薄型高感度磁気センサにおいて、前記磁性ワイヤは、直径20μm以下で、導電性と20G以下の異方性磁界を有し、かつ少なくとも円周方向スピンの配列を持つ表面磁区構造を有しており、前記検出コイルは、コイルピッチが10μm以下であることを特徴とする超薄型高感度磁気センサ。

## 【請求項3】

請求項1に記載されている超薄型高感度磁気センサにおいて、前記絶縁性レジスト層の厚みは前記磁性ワイヤを整流する溝の深さと同一であることを特徴とする超薄型高感度磁気センサ。

## 【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載されている超薄型高感度磁気センサにおいて、前記電極は、前記絶縁保護被膜および前記絶縁性レジスト層を貫いて前記ASICの素子連結用電極と直接接合していることを特徴とする超薄型高感度磁気センサ。

## 【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか 1 項に記載されている超薄型高感度磁気センサにおいて、前記 A S I C は、前記磁界検出素子の前記磁性ワイヤに 0 . 2 G H z ~ 4 . 0 G H z の換算周波数のパルス電流を流す手段と前記磁性ワイヤにパルス電流を流した時に前記検出コイルに生じるコイル電圧を検出する手段と前記コイル電圧を外部磁界 H に比例する電気信号に変換する手段を有することを特徴とする超薄型高感度磁気センサ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、磁界検出素子と特定用途向け集積回路（以下、A S I C という。）との一体形成により磁気センサのサイズや厚みを超小型化する技術に関するものである。

10

より具体的には、磁性ワイヤと磁性ワイヤを周回する検出コイルと電極とを備えている磁界検出素子に代表される G S R 素子、M I 素子に関するものである。

ここで、G S R 素子とは超高速スピン回転効果（英語表記；G H z S p i n R o t a t i o n e f f e c t）を基礎にした高感度マイクロ磁気センサである G S R センサ用素子である。

M I 素子とは磁化の回転現象を活用し磁気交流抵抗効果（Magneto-Impedance）を基礎にした高感度マイクロ磁気センサである G S R センサ用素子である。

## 【背景技術】

## 【0002】

20

高感度マイクロ磁気センサには、ホールセンサ、G M R センサ、T M R センサ、高周波キャリアセンサ、横型 F G センサ、縦型 F G センサ、M I センサ、G S R センサ、などがある。現在、これらのセンサは、スマートフォン、自動車、医療、ロボットなどに広く採用されている。ホールセンサ、G M R センサ、T M R センサ、高周波キャリアセンサは、A S I C と素子が一体化されており、小型化、薄型化が実現しているが、検出感度の改善が課題となっている。一方、横型 F G センサ、縦型 F G センサ、M I センサ、G S R センサは、高い検出感度を有するが、素子と A S I C が二つの部品に分かれており、サイズ面の小型化が課題となっている。G S R センサ（特許文献 1）は、感度面とサイズ面において優れており、素子と A S I C の一体化による G S R センサの小型化、薄型化は最も注目されている課題である。

30

## 【0003】

現在、カテーテルなどのような生体内モーションデバイスに磁気センサを搭載して位置や方位を求めて、その測定値を活用したリモートコントロール治療を実現するための研究（特許文献 2、3）が進んでいる。

生体内モーションデバイスに搭載するためには、センササイズを極限的に小さくする必要がある。一般的にはセンササイズが小さいほど、それに反比例して検出感度が低下するので、必要な検出感度を保ちながら小型化するのは難しい。例えばカテーテルに搭載する場合には、サイズ面では幅 0 . 1 m m、長さ 0 . 3 m m、厚み 0 . 0 5 m m 程度の超小型サイズで、磁界検出力の面では 0 . 1 m G から 1 m G 程度の優れた超高感度性能を兼ね合わせ持つ磁気センサの開発が期待されている。

40

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

【文献】特許第 5 8 3 9 5 2 7 号

特開 2 0 1 5 - 1 3 4 1 6 6 号公報

特開 2 0 1 7 - 1 2 8 4 0 号公報

特開 2 0 1 4 - 1 5 3 3 0 9 号公報

再表 2 0 1 4 - 0 4 2 0 5 5 号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

50

## 【 0 0 0 5 】

磁気センサを小型化するために、G S R素子やM I素子の小型化、A S I Cの小型化および両部品の接合方法（特許文献4）など多面的に取り組まれている。しかし、いずれの取り組みも素子とA S I Cを別々に分けて2部品として製造してから、両者を接合しているために小型化、特に厚みの縮小という点で限界があった（特許文献4および特許文献5）。

## 【課題を解決するための手段】

## 【 0 0 0 6 】

本発明者は、A S I CとG S R素子、M I素子（以下、素子という。）との接合について鋭意検討した結果、A S I C本体の絶縁保護被膜上に、所定の厚みの絶縁性レジスト層（以下、レジスト層という。）を直接形成し、そのレジスト層に、磁性ワイヤを配列する溝を形成し、磁性ワイヤとその磁性ワイヤを周回する検出コイルおよび電極からなる素子を一体形成することにより小型化、薄型化できることに想到した。

## 【 0 0 0 7 】

A S I Cの保護被膜としては、S i O<sub>2</sub>、A l<sub>2</sub>O<sub>3</sub>などの酸化物およびS i Nなどの窒化物が使用されているが、その保護被膜の上に所定の厚さの絶縁性レジストを塗布してそれを基板として素子の形成を試みた。素子をA S I C表面上の2層構造を持つ絶縁層に直接形成する場合に、素子の製造プロセスには、マイクロ溝の加工、反応性イオンエッチング処理、C F<sub>4</sub>ガスプラズマ処理、レジスト加熱キュア処理、酸やアルカリを使う現像処理などの工程が含まれており、それらの工程がA S I C表面の絶縁保護被膜とA S I C回路の機能性の損傷する危険があるが、絶縁性レジストの厚みを1 μm以上で20 μm以下にした場合、それらの損傷は生じず、素子の形成が可能であることを見出した。

これに対して、S i O<sub>2</sub>などの絶縁保護被膜を厚く形成してその上に素子を形成する方法は、保護被膜内部に生じる内部応力が増加して安定した膜品質を得る上で難点があり、2層の絶縁被膜構造を採用する本発明の製造方法の方が、品質面で有利である。

## 【 0 0 0 8 】

またA S I Cの電極と素子の電極を接合するために、レジスト層を貫通するスルーホール式の接合を採用した。これにより、ワイヤボンディングが省略されて、ノイズが低減した。さらに電極のサイズを小さくすることができ、素子全体の面積を小さくできる。

## 【 0 0 0 9 】

レジスト層の厚みと溝の深さとホールの深さを同一とすることで、製造品質を改善できることを見出した。溝加工とホール加工を一回の反応性イオンエッチング処理で形成できる。また一回の下コイル配線加工処理で、溝面の下コイル、電極配線を一度の配線処理で実施できるので工程のバラツキが著しく軽減できるからである。

## 【発明の効果】

## 【 0 0 1 0 】

本発明によれば、G S Rセンサ、M Iセンサの超薄型化、超小型化が可能になる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【 0 0 1 1 】

【図1】実施形態および実施例におけるA S I C一体型超薄型高感度磁気センサおよびG S R素子の平面図である。

【図2】図1のA 1 - A 2線における断面図である。

【図3】図1のB 1 - B 2線における断面図である。

【図4】実施形態および実施例における電子回路の図である。

【図5】素子にパルス電流を通電した時の通電時間の経過とパルス電流の印可との関係図である。

## 【発明を実施するための最良の形態】

## 【 0 0 1 2 】

本発明の実施形態は次の通りである。

本発明の超薄型高感度磁気センサは、特定用途向け集積回路（以下、A S I Cという。）とA S I Cの配線平面上に形成された絶縁保護被膜と絶縁保護被膜上に形成された絶縁性

10

20

30

40

50

レジスト層とからなる基板上に、磁性ワイヤと磁性ワイヤを周回する検出コイルと電極とからなる磁界検出素子を形成することからなっている。

磁性ワイヤは、直径  $20\ \mu\text{m}$  以下で、導電性と  $20\ \text{G}$  以下の異方性磁界を有し、かつ円周方向スピン配列を持つ表面磁区と軸方向にスピン配列を持つ中央部コア磁区の 2 相の磁区構造を有している。検出コイルは、コイルピッチ  $10\ \mu\text{m}$  以下である。

電極は、絶縁性レジスト層を貫いて素子の電極と A S I C 面上の電極をスルーホール方式で直接接合する。

#### 【0013】

本発明によれば、A S I C 表面の絶縁保護被膜上に磁界検出素子の基板皮膜としての機能を果たすことができる厚みの絶縁レジスト層（以下、レジスト層という。）を形成し、そのレジスト層を基板皮膜として用いる。レジスト層に溝を形成し、溝に磁性ワイヤを整列させてそれにコイルを巻き付けて磁界検出素子を作製する。このようにすることにより、磁界検出素子と A S I C と一体形成したセンサは超薄型化が可能となる。

#### 【0014】

また、本発明の超薄型高感度磁気センサの A S I C は、G S R センサの場合には磁界検出素子の磁性ワイヤに  $0.2\ \text{GHz} \sim 4.0\ \text{GHz}$  の換算周波数のパルス電流を流す手段と、磁性ワイヤにパルス電流を流した時に生じるコイル電圧を検知する手段と、コイル電圧を外部磁界  $H$  に比例する電気信号に変換する手段を有する。ここで、換算周波数とは、パルス立上りまたは立下り時間  $t$  秒を高周波の波の一部と見なして、 $f = 1 / 2t$  で定義したものである。 $t = 0.5\ \text{ns}$  秒の場合、換算周波数は  $1\ \text{GHz}$  となる。

#### 【0015】

また、本発明の超小型高感度磁気センサのレジスト層の厚みは、 $1\ \mu\text{m} \sim 20\ \mu\text{m}$  からなり、レジスト層の厚みと溝の深さが同等であることが好ましい。

本発明によれば、レジスト層は磁性ワイヤを収める溝を付けられるだけの厚みを必要とし、磁性ワイヤの直径は  $1\ \mu\text{m} \sim 20\ \mu\text{m}$  である。

また、絶縁保護被膜の厚みは、一般的には A S I C の保護機能を有するのに十分な厚さを確保することによい。

#### 【0016】

さらに、本発明の超小型高感度磁気センサは、磁界検出素子はレジスト層の上面から深さ  $1\ \mu\text{m} \sim 20\ \mu\text{m}$  の溝を配置し、磁性ワイヤの一部又は全部が埋設されている。

#### 【0017】

以下に、A S I C 一体型超薄型高感度磁気センサ（以下、磁気センサという。）と磁界検出素子（以下、素子という。）の平面図を図 1 に示し、その平面図の A 1 - A 2 線の断面図を図 2 に、B 1 - B 2 線の断面図を図 3 に示して、本発明の実施形態について詳細に説明する。

本説明では、磁性ワイヤは 1 本からなり、絶縁保護被膜とレジスト層の 2 層からなる形態について説明する。本発明の磁気センサは、素子 1 と A S I C 4 および A S I C 4 の外部配線用電極 4 4 からなる。

#### 【0018】

##### < 磁気センサ >

磁気センサを構成する素子 1 は、A S I C 4 の絶縁保護被膜 4 1 の上に形成される基板皮膜（レジスト層）1 1 の上に 1 本の磁性ワイヤ 2 とその磁性ワイヤを周回する 1 個のコイル 3 およびワイヤ通電用の 2 個のワイヤ電極 2 3 とコイル電圧検出用の 2 個のコイル電極 3 5 ならびに磁性ワイヤ 2 のワイヤ端子 2 4 とワイヤ電極 2 3 とのワイヤ接続部 2 5、素子側のワイヤ電極 2 3 と A S I C 側の素子連結用のワイヤ電極 4 2 とのスルーホール方式の電極接合部 4 3 からなる。同様に検出コイル 3 とコイル検出コイル 3 5 から接続されているコイル電極 3 5 および素子側のコイル電極 3 5 と A S I C 側の素子連結用のコイル電極とのスルーホール方式の接合部からなる。

そして、A S I C 4 は、素子 1 との間は 2 個のコイル電極および 2 個のワイヤ電極がそれぞれスルーホール方式の電極接合部により接続されて、素子にパルス電流を流したときに

10

20

30

40

50

検出コイルに生じるコイル電圧を検知し、コイル電圧を外部磁界に変換する電子回路からなる。また、A S I C には 4 個の外部配線用電極 4 4 が配置されている。

【 0 0 1 9 】

ここで、G S R センサにおける検知したコイル電圧から外部磁界を求める方法について説明する。

外部磁界 H とコイル電圧 V s は、次式 ( 1 ) のような数学的関係で表され、本関係式を使って外部磁界 H に変換するものである。

$$V s = V 0 \cdot 2 L \cdot D \cdot p \cdot N c \cdot f \cdot \sin ( H / 2 H m ) \quad ( 1 )$$

ここで、V s はコイル出力電圧、V 0 は比例定数、L はワイヤの長さ、D はワイヤの直径、p はパルス電流の表皮深さ、N c はコイルの巻き数、f はパルス周波数、H m はコイル出力電圧が最大値を取る時の外部磁界強度である。

10

【 0 0 2 0 】

< 素子の構造 >

素子 1 の構造は、図 1 ~ 図 3 に示すとおりである。

素子 1 のサイズは、幅 0 . 0 7 m m ~ 0 . 4 m m 、長さ 0 . 2 5 m m ~ 1 m m である。厚みは 1 0 μ m ~ 2 0 μ m である。よって、A S I C 4 の厚みが 3 0 μ m ~ 1 0 0 μ m であることからセンサの厚みは 4 0 μ m ~ 1 2 0 μ m となる。

素子 1 には、磁性ワイヤ 2 が整列できるように幅 1 0 μ m ~ 2 0 μ m 、深さ 1 μ m ~ 2 0 μ m の溝 1 2 がレジスト層 1 1 に形成されている。

【 0 0 2 1 】

20

< 磁性ワイヤ >

磁性ワイヤ 2 は、C o F e S i B 合金の直径 1 μ m ~ 2 0 μ m である。磁性ワイヤ 2 の周囲は絶縁性材料、例えば絶縁性ガラス材料で被覆されていることが好ましい。長さは 0 . 0 7 m m ~ 1 m m である。

磁性ワイヤ 2 の異方性磁界は 2 0 G 以下で、円周方向スピン配列を持つ表面磁区と軸方向にスピン配列を持つ中央部コア磁区の 2 相の磁区構造を有する。少なくとも円周方向スピン配列を持つ表面磁区を有することが重要である。

【 0 0 2 2 】

< 検出コイル >

検出コイル 3 は、コイル巻き数は 6 回 ~ 1 8 0 回、コイルピッチは 0 . 2 μ m ~ 1 0 μ m である。検出コイル 3 と磁性ワイヤ 2 との間隔は 0 . 2 μ m ~ 3 μ m である。コイル平均内径は 2 μ m ~ 2 5 μ m である。

30

【 0 0 2 3 】

< 素子の製造方法 >

A S I C の表面の絶縁保護被膜 4 1 に絶縁性レジスト層からなる基板皮膜 1 1 を形成し、その基板皮膜 1 1 に深さ 1 μ m ~ 2 0 μ m の溝を形成し、溝面に沿って磁性ワイヤの一部 ~ 全部を埋設するように素子 1 を形成することによって A S I C 表面から素子部 1 の厚みを 2 0 μ m 以下にすることができる。さらに A S I C の厚みを 3 0 μ m ~ 5 0 μ m とすることによりセンサ全体の厚みを 5 0 μ m ~ 7 0 μ m 程度とすることができる。

【 0 0 2 4 】

40

ここで、A S I C 4 の絶縁保護被膜 4 1 の厚みは A S I C 4 の電氣的絶縁性と素子 1 の形成過程における物理的・化学的に耐えられる限り薄くてもよい。

【 0 0 2 5 】

3 次元フォトリソ技術でレジスト層 1 1 に形成されている溝 1 2 に沿って下コイル 3 1 を、レジスト層 1 1 の上に電極配線を同時に行う。

次いで、磁性ワイヤ 2 を溝 1 2 に沿って設置した後、レジスト層 1 1 の全面にレジストを塗布して磁性ワイヤ 2 は溝 1 2 内に固定する。この塗布の際に磁性ワイヤ 2 の上部は薄く塗布する。その後、そこに上コイル 3 2 を 3 次元フォトリソ技術で形成する。

【 0 0 2 6 】

ここで、A S I C 面の絶縁保護被膜 4 1 とレジスト層 1 1 の 2 層からなる基板皮膜 1 1 a

50

を用いることにより、マイクロ溝加工、レジスト加熱キュア処理、酸やアルカリを使う現像処理などの工程における耐性とA S I C回路の機能性低下の防止が可能となる。また2層からなる基板皮膜11aは、A S I Cの保護機能と必要な厚さを確保して素子形成を可能とする機能とを分けることによって、製造が一層のS i O<sub>2</sub>被膜やS i N被膜に比べて容易となっている。

なお、ガラス被覆していない磁性ワイヤ2を用いる場合には、下コイル31と磁性ワイヤ2とが電氣的な接触が生じないように予め絶縁性材料を塗布する。

#### 【0027】

検出コイル3の作製は、レジスト層11に形成された溝12の溝面および溝12の両側に沿って凹形状の下コイル31が形成される。凸形状の上コイル32はジョイント部33を介して下コイル31と電氣的接合がされ、らせん状の検出コイル3となる。

10

#### 【0028】

磁性ワイヤ2の端部については、絶縁性被膜材のガラスを除去して金属蒸着による電氣的接続をできるようにする。

#### 【0029】

<磁性ワイヤとコイルの配線構造>

磁性ワイヤ2と検出コイル3の配線構造について、図1を用いて説明する。

磁性ワイヤ2の配線構造は、磁性ワイヤ2の両端にそれぞれワイヤ端子24を形成し、ワイヤ電極接続部25を介してワイヤ電極23に接続される。

#### 【0030】

20

検出コイル3の配線構造は、検出コイル3と検出コイル3の両端部から接続される2個のコイル電極35とからなる。

#### 【0031】

素子側の電極とA S I C側の電極とは、図3の例に示すように絶縁保護被膜41およびレジスト層11を貫通するスルーホール方式の接合部43を介して電氣的に接続される。

図3は、素子側のワイヤ電極23はレジスト層11および絶縁保護被膜41を貫通するスルーホール方式の電極接合部43を介してA S I C側のワイヤ電極42と接続されていること示している。

同様に、素子側のコイル電極とA S I C側のコイル電極とはレジスト層11を貫通する電極接合部を介して接続されている。

30

#### 【0032】

<電子回路>

電子回路5は、特許文献1に記載のパルス対応型バッファ回路を参照し、図4に示す。

電子回路5は、コイル電圧を出力する素子52が接続されており、その素子52にパルス電流を発信するパルス発振回路51、コイル電圧を入力する入力回路53、パルス対応型バッファ回路54、コイルの立ち上がりパルス出力波形のピーク電圧を検波する電子スイッチ56とピーク電圧を保持する容量4pF~100pFのコンデンサ57からなるサンプルホールド回路55、および増幅器58のプログラミングアンプにて増幅してA D変換を行なう。2本のワイヤにて信号を外部の信号処理装置に転送する。

なお、コイル電圧のI Rドロップの影響が少ない場合はパルス対応型バッファ回路を省略してもよい。

40

#### 【0033】

A D変換は14ビット~16ビットである。電子スイッチのon-offを細かくするためにはコンデンサ容量は4pF~8pFが好ましい。

#### 【0034】

パルス電流の換算周波数は0.2GHz~4GHzにて、パルス電流の強度は50mA~200mA、パルス通電時間は2nsec以下である。図5には、素子にパルス電流を通電した時の通電時間の経過とパルス電流の印可との関係を表している。この図5の例では、0.5nsecで立ち上がり、その印可状態で所定のパルス時間0.5nsecを保持し、0.5nsecで立ち下がる。

50

## 【 0 0 3 5 】

コイル出力は正弦波出力にて測定レンジ  $3\text{ G} \sim 100\text{ G}$  で、その感度は  $50\text{ mV} / \text{G} \sim 3\text{ V} / \text{G}$  である。そのコイル出力の直線性は  $0.03\%$  以下である。

## 【実施例】

## 【 0 0 3 6 】

実施例に係る A S I C 一体型超小型高感度磁気センサである G S R センサと G S R センサ素子の平面図を図 1 に示し、その平面図の A 1 - A 2 線の断面図を図 2 に、B 1 - B 2 線の断面図を図 3 に示して、本発明の実施例について説明する。

ここで、G S R センサの構成および素子の構成、電子回路は上述の実施形態による。

## 【 0 0 3 7 】

素子 1 のサイズは、幅  $0.10\text{ mm}$ 、長さ  $0.40\text{ mm}$  からなる。厚みは A S I C 4 の厚み  $50\text{ }\mu\text{m}$ 、絶縁保護被膜 4 1 およびレジスト層 1 1 の厚みとの合計 1 1 a が  $8\text{ }\mu\text{m}$  で、素子の凸部の厚みが  $2\text{ }\mu\text{m}$ 、これらを合計したセンサの厚みは  $60\text{ }\mu\text{m}$  である。

## 【 0 0 3 8 】

磁性ワイヤ 2 は、C o F e S i B アモルファス合金の直径  $10\text{ }\mu\text{m}$  である。磁性ワイヤ 2 の周囲は絶縁性ガラスで被覆されている。長さは  $0.40\text{ mm}$  である。

磁性ワイヤ 2 の異方性磁界は  $15\text{ G}$  で、円周方向スピンの配列を持つ表面磁区と軸方向にスピンの配列を持つ中央部コア磁区の 2 相の磁区構造を有している。

## 【 0 0 3 9 】

検出コイル 3 は、コイル巻き数は 100 回、コイルピッチは  $5\text{ }\mu\text{m}$  である。コイル 3 と磁性ワイヤ 2 との間隔は  $2\text{ }\mu\text{m}$  で、コイル平均内径は  $12\text{ }\mu\text{m}$  である

## 【 0 0 4 0 】

A S I C 上面の絶縁保護被膜 4 1 に厚み  $7\text{ }\mu\text{m}$  のレジスト層 1 1 を形成し、そこにレジスト層の厚みと同じ深さ  $7\text{ }\mu\text{m}$  の溝を取り付け、素子 1 を作製する。

## 【 0 0 4 1 】

電子回路 5 のコンデンサ 5 7 の静電容量は  $6\text{ pF}$  である。パルス電流の換算周波数は  $1.5\text{ GHz}$  にて、パルス電流の強度は  $50\text{ mA}$ 、パルス時間は  $1\text{ nsec}$  である。立ち上がりパルスのピーク電圧のタイミングを検波する。電子スイッチは on - off からなりその開閉時間は  $0.1\text{ nsec}$  で繰り返す。電子回路 5 の A D 変換は 16 ビットである。

## 【 0 0 4 2 】

コイル出力は、測定レンジ  $3\text{ G}$  で、その感度は  $1000\text{ mV} / \text{G}$  である。直線性は  $0.25\%$  である。

## 【産業上の利用可能性】

## 【 0 0 4 3 】

本発明は、素子と A S I C とを一体化して G S R センサの超薄型化・超小型化を実現するもので、生体内のモーションデバイスのように超小型で高性能を要求される用途での使用が期待される。

## 【 0 0 4 4 】

本発明は、自動車用あるいはウェアラブルコンピュータ用などの小型・超高感度の G S R センサに応用可能である。

## 【符号の説明】

## 【 0 0 4 5 】

1 : 素子

1 0 : 素子の厚み、1 1 : 基板皮膜 ( レジスト層 )、1 1 a : 2 層の厚み、1 2 : 溝

2 : 磁性ワイヤ

2 1 : 磁性ワイヤ ( CoFeSiB 合金 )、2 2 : 絶縁性ガラス、2 3 : ワイヤ電極、2 4 : ワイヤ端子、2 5 : ワイヤ電極接続部

3 : 検出コイル

3 1 : 下コイル、3 2 : 上コイル、3 3 : ジョイント部、3 4 : 絶縁性レジスト、3 5 :

コイル電極

10

20

30

40

50

4 : A S I C

4 0 : A S I C の厚み、4 1 : A S I C 絶縁性保護被膜、4 2 : A S I C 側ワイヤ電極、  
4 3 : スルーホール方式電極接合部、4 4 : 外部配線用電極、4 5 : 外部配線

5 : 電子回路

5 1 : パルス発信回路 ( パルス発信器 )、5 2 : 素子、5 3 : 入力回路、5 4 : バッファ  
ー回路、5 5 : サンプルホールド回路、5 6 : 電子スイッチ、5 7 : コンデンサ、5 8 :  
増幅器

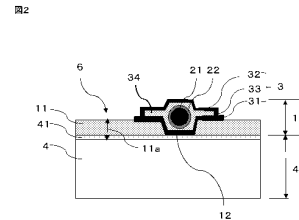
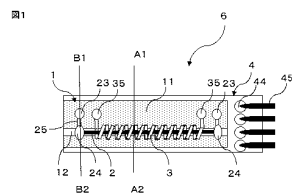
6 : A S I C 一体型超薄型高感度磁気センサ

【図面】

【図 1】

【図 2】

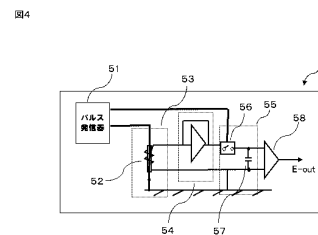
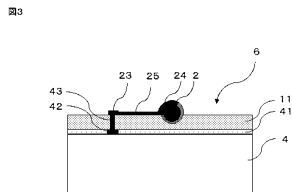
10



20

【図 3】

【図 4】



30

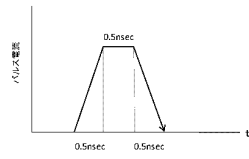
40

50



【 図 5 】

図5



10

20

30

40

50

## フロントページの続き

A r i e s 2 0 2

(72)発明者 菊池 永喜  
愛知県東海市荒尾町寿鎌 1 0 9 番地

合議体

審判長 岡田 吉美

審判官 濱野 隆

審判官 中塚 直樹

(56)参考文献 特開 2 0 1 9 - 2 0 3 4 6 ( J P , A )  
特表 2 0 1 8 - 5 0 7 5 5 9 ( J P , A )  
特開平 5 - 2 9 4 5 6 ( J P , A )  
特許第 6 3 0 2 6 1 3 ( J P , B 1 )  
特開 2 0 0 6 - 3 1 9 0 9 4 ( J P , A )  
米国特許出願公開第 2 0 0 7 / 0 0 3 7 4 0 6 ( U S , A 1 )  
特開 2 0 0 7 - 2 8 1 2 3 0 ( J P , A )  
特開 2 0 0 6 - 0 1 3 3 7 0 ( J P , A )  
特開平 0 9 - 0 7 9 8 6 5 ( J P , A )

(58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)  
G01R 33/00-33/26